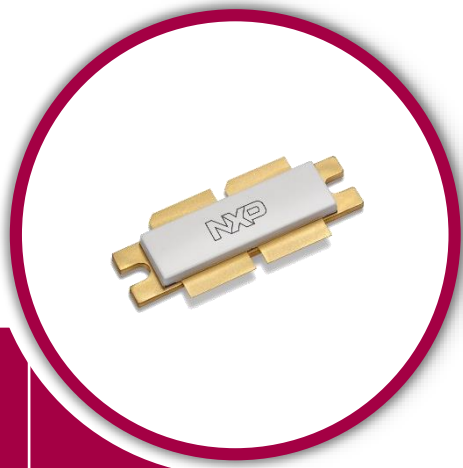


MRFX1K80H НОВИНКА

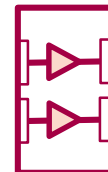
- 1800 Вт CW
- 1.8-470 МГц
- 65 В LDMOS
- Несогласованный вход и выход
- Двухтактное исполнение
- Керамический корпус
- Термическое сопротивление 0.09°C/Вт
- $V_{(BR)DSS}$ 182 В минимум
- VSWR 65:1
- Гарантированная доступность до 2032 года



Комментарии:

Разработан для простоты применения:

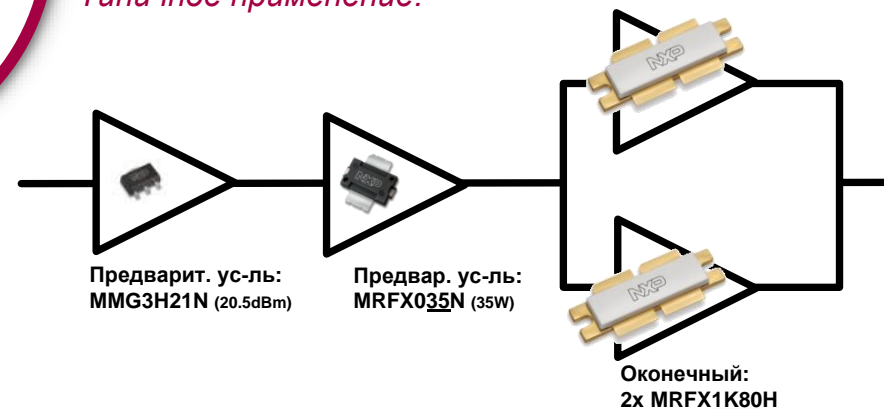
- 65В - увеличивает плотность мощности
- 65В - обеспечивает высокий импеданс
- 65В - большее напряжение пробоя
- 65В - меньший ток в системе
- Совместимость с MRFE6VP61K25 и MRF1K50



Типичные характеристики:

Частота	Тип сигнала	V_p , В	$P_{вых}$, Вт	Усил-е, дБ	КПД, %	
27	CW	50	1200	26.0	82.3	Март 2017
		57.5	1520	27.0	80.1	
		65	1800	27.8	75.6	
87.5-108	CW	50	1140	19.8	83.4	Апр, 2017
		60	1615	21.3	82.6	
144	CW	65	1800	23.5	77.5	Июль, 2017
230	Pulse	65	1800	24.0	74.0	Июль, 2017

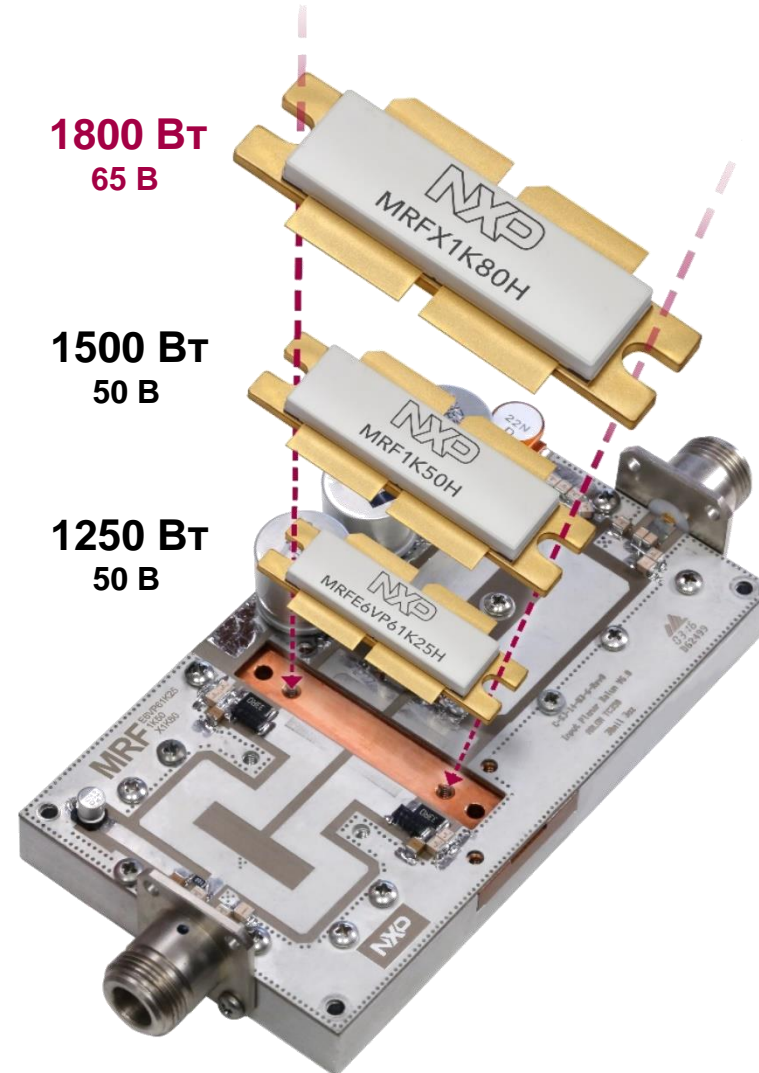
Типичное применение:



Стратегия по NXP RF Транзисторам: Фокус на **Унификации**

Транзисторы серии MRFX применимы в существующих дизайнах PCB для предыдущих поколений

- Один дизайн для MRFE6VP61K25H, MRE6VP61K25N, MRF1K50H, MRF1K50N, **MRFX1K80H**, **MRFX1K80N**
- Требуется небольшая подстройка или не требуется вообще



- Быстрый выход на рынок
- Одна платформа - несколько продуктов